

КТ503А, КТ503Б, КТ503В, КТ503Г, КТ503Д, КТ503Е:

Транзисторы КТ503 кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные.

Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных устройствах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Тип корпуса: КТ-26.

Технические условия: аА0.336.183 ТУ/02.

Технические характеристики транзисторов КТ503А, КТ503Б, КТ503В, КТ503Г, КТ503Д, КТ503Е:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$							$T_{п\text{ max}}$	$T_{\text{ max}}$	
		$I_{к\text{ max}}$	$I_{к.и.\text{ max}}$	$U_{к\text{ э0\text{ max}}}$	$U_{к\text{ б0\text{ max}}}$	$U_{э\text{ б0\text{ max}}}$	$R_{к\text{ max}}$ ($R_{к.т.\text{ max}}$)	$h_{21Э}$	$U_{к\text{ э на с.}}$	$I_{к\text{ б о}}$	$I_{э\text{ б о}}$	$f_{гр.}$	$K_{ш}$	$C_{к}$			$C_{э}$
		А	А	В	В	В	Вт		В	мкА	мкА	МГц	дБ	пФ			пФ
КТ503А	n-p-n	0,1 5	0,3 5	25	40	5	0,3 5	40...1 20	0,6	1	-	5	-	50	-	12 5	- 40...+ 85
КТ503Б	n-p-n	0,1 5	0,3 5	25	40	5	0,3 5	80...2 40	0,6	1	-	5	-	50	-	12 5	- 40...+ 85
КТ503В	n-p-n	0,1 5	0,3 5	40	60	5	0,3 5	40...1 20	0,6	1	-	5	-	50	-	12 5	- 40...+ 85
КТ503Г	n-p-n	0,1 5	0,3 5	40	60	5	0,3 5	80...2 40	0,6	1	-	5	-	50	-	12 5	- 40...+ 85
КТ503Д	n-p-n	0,1 5	0,3 5	60	80	5	0,3 5	40...1 20	0,6	1	-	5	-	50	-	12 5	- 40...+ 85
КТ503Е	n-p-n	0,1 5	0,3 5	80	100	5	0,3 5	40...1 20	0,6	1	-	5	-	50	-	12 5	- 40...+ 85

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- **$I_k \max$** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- **$I_k.и. \max$** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **$U_{кэR} \max$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **$U_{кэ0} \max$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- **$U_{кб0} \max$** - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- **$U_{эб0} \max$** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **$P_k \max$** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$P_k.т. \max$** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора с теплоотводом.
- **$h_{21Э}$** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **$U_{кэ \text{нас.}}$** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **$I_{кб0}$** - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **$I_{эб0}$** - обратный ток эмиттера. Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
- **$f_{гр}$** - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **$K_{ш}$** - коэффициент шума транзистора.
- **C_k** - емкость коллекторного перехода.
- **$C_э$** - емкость коллекторного перехода.
- **$T_p \max$** - максимально допустимая температура перехода.
- **$T \max$** - максимально допустимая температура окружающей среды.